



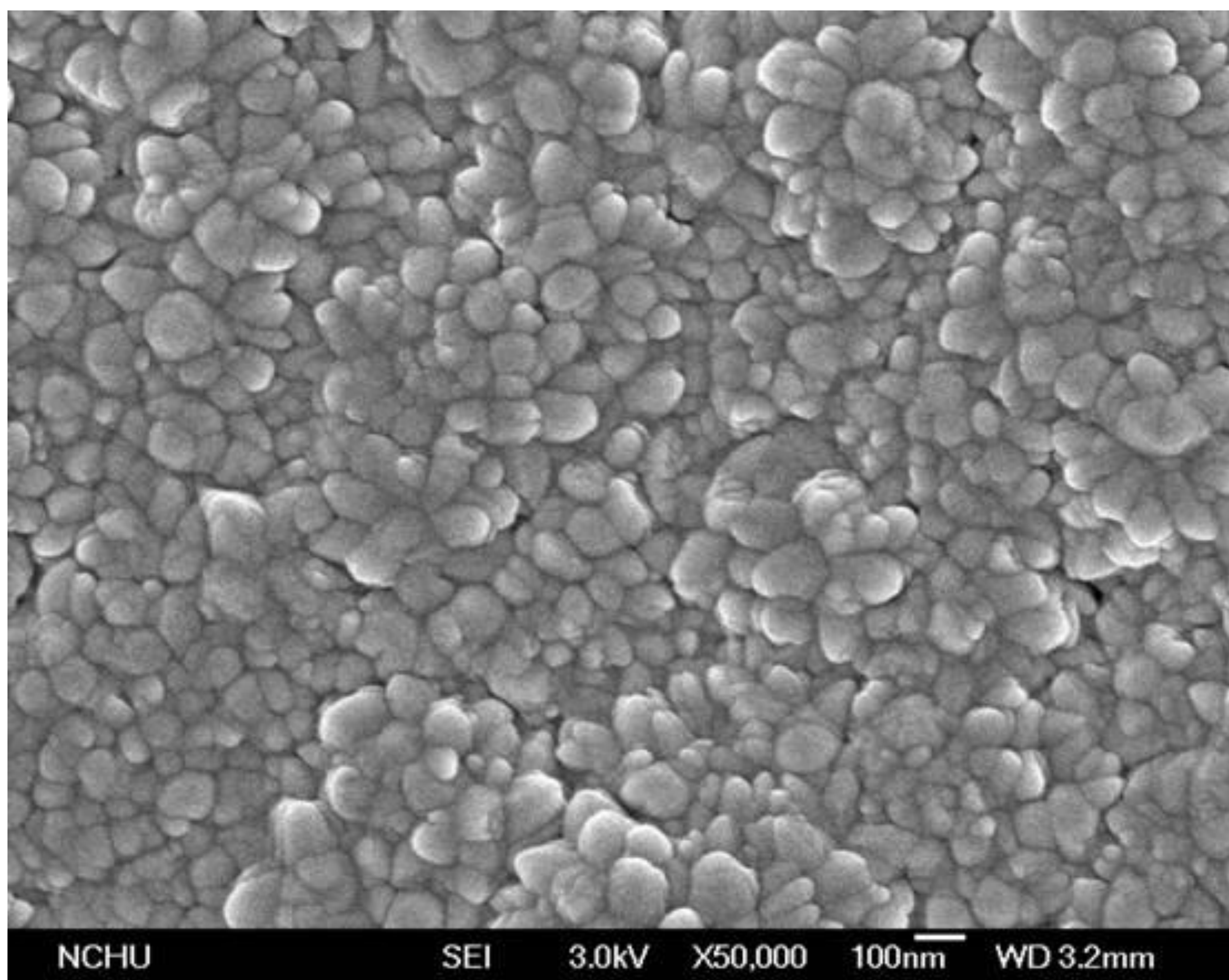
低溫化學水浴法(CBD)沉積硫化鎘緩衝層薄膜特性及研究

發明人:楊立中

技術內容

本實驗以低溫及高溫化學水浴沉積法(CBD)來製備硫化鎘(II-VI化合物)半導體薄膜沉積於載玻片上，並藉由在不同配方的製程下沉積，量測其光電特性。此種製程的理念為改善在製程中產生大量鎘浪費以及縮短製程上時間的情形、減少氨水的使用量，來製成低成本、低污染以及效率更好的太陽能電池。在製程條件上溫度是以50°C為主，並改變其鍍液反應時間、反應溫度、反應物濃度變化、以及pH值變化、和不同錯合劑的摻雜以及錯合劑的濃度變化等各種參數變化，來分析其高溫及低溫的薄膜特性及性質來達到更好的光電特性，進而縮短時間上及成本上的消耗。

技術圖片



沉積於CIGS薄膜上之緩衝層表面顯微組織

聯絡窗口：國立虎尾科技大學 智財技轉組 王偉儒

聯絡電話：05-6315561

網址：<http://nfu-test.eipm.com.tw/index.asp>